

# КТ118Б

Транзисторы КТ118Б кремниевые эпитаксиально-планарные двухэмиттерные структуры р-п-р переключаательные.

Предназначены для применения в модуляторах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Тип корпуса: КТ1-7.

Технические условия: ЖКЗ.365.238 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора КТ118Б:

- Структура транзистора: р-п-р
- $P_{к\max}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 100 мВт;
- $U_{кб\text{ проб}}$  - Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 15 В;
- $U_{эб\text{ проб}}$  - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 16 В;
- $I_{к\max}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 50 мА;
- $I_{кб\text{ об}}$  - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 0,1 мкА;
- $R_{кэ\text{ нас}}$  - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: 100 Ом

## Технические характеристики транзисторов КТ118А, КТ118Б, КТ118В:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						Значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						$T_{\max}$ °C			
		$I_{к\max}$	$I_{к.и.\max}$	$U_{кэR\max}$ ( $U_{кэ0\max}$ )	$U_{кб0}$	$U_{эб0}$	$P_{к\max}$	$h_{21Э}$	$U_{кэ\text{нас}}$	$I_{кб\text{об}}$	$I_{эб\text{об}}$	$f_{гр.}$	$K_{ш}$		$C_{к}$	$C_{э}$	
		мА	мА	В	В	В	мВт		В	мкА	мкА	МГц	дБ		пФ	пФ	
КТ118А	р-п-р	50	-	-	15	31	100	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	60...+125
КТ118Б	р-п-р	50	-	-	15	16	100	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	60...+125
КТ118В	р-п-р	50	-	-	15	16	100	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	60...+125

Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- $I_{к\max}$  - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.

- **$I_{к. и. max}$**  - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- **$U_{кэR max}$**  - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **$U_{кэ0 max}$**  - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- **$U_{кб0 max}$**  - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- **$U_{эб0 max}$**  - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- **$P_{к max}$**  - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **$h_{21Э}$**  - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- **$U_{кэ нас.}$**  - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- **$I_{кб0}$**  - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- **$I_{эб0}$**  - обратный ток эмиттера. Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора.
- **$f_{гр}$**  - граничная частота коэффициента передачи тока.
- **$K_{ш}$**  - коэффициент шума транзистора.
- **$C_{кк}$**  - емкость коллекторного перехода.
- **$C_{ээ}$**  - емкость эмиттерного перехода.
- **$T_{п max}$**  - максимально допустимая температура перехода.
- **$T_{ max}$**  - максимально допустимая температура окружающей среды.